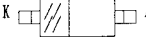
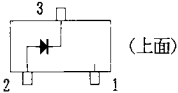
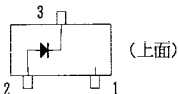
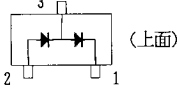
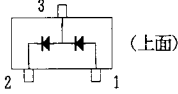
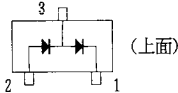
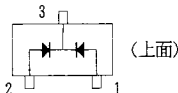
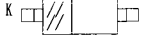


一 般 項 目	最大定格		電 気 的 特 性					備 考	ピ ン 接 続 図
	項 目	定格値	項 目	最 小	標 準	最 大	測 定 条 件		
●HSU277 日立 用途：VHF/UHF チューナバンドスイッチ 特長：低順動作抵抗なので、挿入損失を小さくできる。	V_R (V)	35	I_R (nA)			50.00	$V_R=25V$		
	P (mW)	150	V_F (V)			1.00	$I_F=10mA$		
	T_j (°C)	125	C_t (pF)			1.20	$V_R=6V, f=1MHz$		
			r_F (Ω)			0.75	$I_F=2mA, f=100MHz$		
●HVM13 日立 用途：高周波用アッテネータ、アンテナ切替スイッチ用 特長：大きな抵抗可変範囲が得られる。	V_R (V)	60	I_R (nA)			100.00	$V_R=60V$		 (上面)
	I_o (mA)	50	V_F (V)			1.00	$I_F=10mA$		
	P (mW)	100	C_t (pF)			2.40	$V_R=0, f=1MHz$		
	T_j (°C)	125	r_F (Ω)	3.50		5.50	$I_F=10mA, f=100MHz$		
●HVM14 日立 用途：VHF/UHF 帯アッテネータ、AGC 用 特長：低直列抵抗、低端子間容量。	V_R (V)	50	I_R (nA)			100.00	$V_R=50V$		 (上面)
	I_F (mA)	50	V_F (V)		0.95		$I_F=50mA$		
	T_j (°C)	125	C_t (pF)		0.25		$V_R=50V, f=1MHz$		
			r_F (Ω)			7.00	$I_F=10mA, f=100MHz$		
●HVM14S 日立 用途：VHF/UHF 帯アッテネータ、AGC 用 特長：低直列抵抗、低端子間容量。	V_R (V)	50	I_R (nA)			100.00	$V_R=50V$		 (上面)
	I_F (mA)	50	V_F (V)		0.95		$I_F=50mA$		
	T_j (°C)	125	C_t (pF)		0.25		$V_R=50V, f=1MHz$		
			r_F (Ω)			7.00	$I_F=10mA, f=100MHz$		
●HVM14SR 日立 用途：VHF/UHF 帯アッテネータ、AGC 用 特長：低直列抵抗、低端子間容量。	V_R (V)	50	I_R (nA)			100.00	$V_R=50V$		 (上面)
	I_F (mA)	50	V_F (V)		0.95		$I_F=50mA$		
	T_j (°C)	125	C_t (pF)		0.25		$V_R=50V, f=1MHz$		
			r_F (Ω)			7.00	$I_F=10mA, f=100MHz$		
●HVM187S 日立 用途：高周波用アッテネータ、アンテナ切替スイッチ用 特長：高周波順抵抗が小さく、低容量。	V_R (V)	60	I_R (nA)			100.00	$V_R=60V$		 (上面)
	I_o (mA)	50	V_F (V)			1.00	$I_F=10mA$		
	P (mW)	100	C_t (pF)			2.40	$V_R=0, f=1MHz$		
	T_j (°C)	125	r_F (Ω)	3.50		5.50	$I_F=10mA, f=100MHz$		
●HVM187WK 日立 用途：高周波用アッテネータ、アンテナ切替スイッチ用 特長：大きな抵抗可変範囲が得られ。	V_R (V)	60	I_R (nA)			100.00	$V_R=60V$		 (上面)
	I_o (mA)	50	V_F (V)			1.00	$I_F=10mA$		
	P (W)	100	C_t (pF)			2.40	$V_R=0, f=1MHz$		
	T_j (°C)	125	r_F (Ω)	3.50		5.50	$I_F=10mA, f=100MHz$		
●HVU187 日立 用途：高周波アッテネータ用。 特長：直流順電流による抵抗可変範囲と高周波動作抵抗の可変範囲が大。	V_R (V)	60	V_F (V)			1.00	$I_F=10mA$	形名表示：D	
	I_o (mA)	50	I_R (nA)			100.00	$V_R=60V$		
	P_d (mW)	100	C (pF)			2.40	$V_R=0, f=1MHz$		
	T_j (°C)	125	r_F (Ω)	3.50		5.50	$I_F=10mA, f=100MHz$		